

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
株式会社 ルネサス テクノロジ
問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-740-A108A/J	Rev.	第1版
題名	7542 グループ データシート追加情報		情報分類	技術情報	
適用製品	7542 グループ・フラッシュ版	対象ロット等	関連資料	7542 グループ データシート	
		全ロット			

7542 グループ データシートに、7542 グループ・フラッシュ版におけるフラッシュメモリの電気的特性を追加致します。
データシートをご使用の際は、留意のほど宜しくお願い致します。

フラッシュメモリの電気的特性

表1 フラッシュメモリの電気的特性

記号	項目	測定条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
-	プログラム/イレーズ回数(注1)		100	-	-	回
-	バイトプログラム時間		-	50	400	μs
-	ブロックイレーズ時間	2K バイトブロック	-	0.2	9	s
		8K バイトブロック	-	0.4	9	s
		16K バイトブロック	-	0.7	9	s
td(SR-ES)	消去動作からイレーズサスペンドへの遷移時間		-	-	8	ms
-	イレーズサスペンドリクエスト間隔		10	-	-	ms
-	プログラム/イレーズ電圧		2.7	-	5.5	V
-	リード電圧		2.7	-	5.5	V
-	プログラム/イレーズ時の温度		0	-	60	
-	データ保存時間	Ta=55	20	-	-	年

注1. プログラム/イレーズ回数の定義

プログラム/イレーズ回数はブロックごとのイレーズ回数です。プログラム/イレーズ回数がn回(n=100)の場合、ブロックごとにそれぞれn回ずつイレーズすることができます。例えば、2K バイトのブロックAについて、それぞれ異なる番地に1バイト書き込みを2048回に分けて行った後に、そのブロックをイレーズした場合も、プログラム/イレーズ回数は1回と数えます。ただし、イレーズ1回に対して、同一番地に複数回の書き込みをしないでください。(上書き禁止)

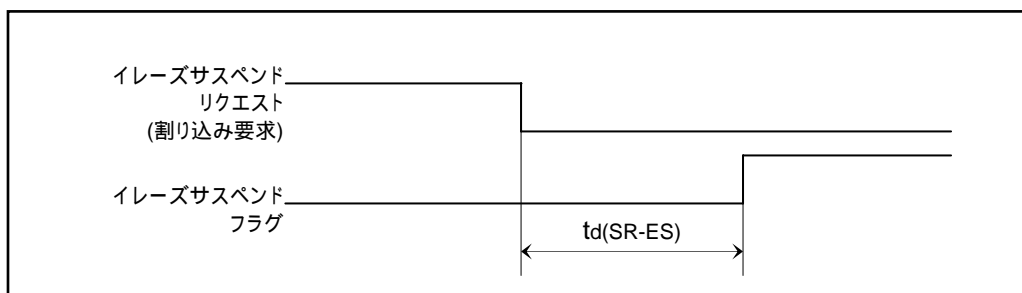


図1 消去動作からイレーズサスペンドへの遷移時間